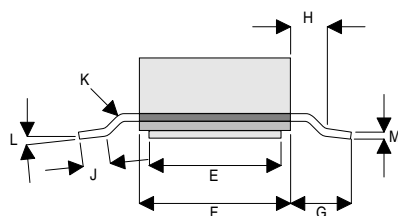
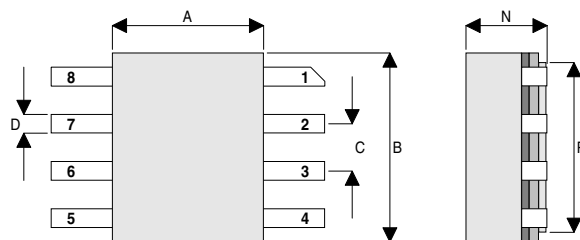


MECHANICAL DATA



SO8 PACKAGE

- PIN 1 – SOURCE
- PIN 2 – DRAIN
- PIN 3 – DRAIN
- PIN 4 – SOURCE
- PIN 5 – SOURCE
- PIN 6 – GATE
- PIN 7 – GATE
- PIN 8 – SOURCE

Dim.	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	4.06	±0.08	0.160	±0.003
B	5.08	±0.08	0.200	±0.003
C	1.27	±0.08	0.050	±0.003
D	0.51	±0.08	0.020	±0.003
E	3.56	±0.08	0.140	±0.003
F	4.06	±0.08	0.160	±0.003
G	1.65	±0.08	0.065	±0.003
H	0.76	+0.25 -0.00	0.030	+0.010 -0.000
J	0.51	Min.	0.020	Min.
	1.02	Max.	0.040	Max.
K	45°	Max.	45°	Max.
	0°	Min.	0°	Min.
L	7°	Max.	7°	Max.
	0°	Min.	0°	Min.
M	0.20	±0.08	0.008	±0.003
N	2.18	Max.	0.086	Max.
P	4.57	±0.08	0.180	±0.003

**GOLD METALLISED
MULTI-PURPOSE SILICON
DMOS RF FET
10W – 28V – 500MHz
SINGLE ENDED**

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- VERY LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 13 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
from 1 MHz to 1GHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	30W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage	70V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage	±20V
$I_{D(sat)}$	Drain Current	5A
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
BV _{DSS} Drain–Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0 I _D = 100mA	70			V
I _{DSS} Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0			1	mA
I _{GSS} Gate Leakage Current	V _{GS} = 20V V _{DS} = 0			1	μA
V _{GS(th)} Gate Threshold Voltage*	I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}	1		7	V
g _{fs} Forward Transconductance*	V _{DS} = 10V I _D = 1A	0.8			S
G _{PS} Common Source Power Gain	P _O = 10W	13			dB
η Drain Efficiency	V _{DS} = 28V I _{DQ} = 0.1A	50			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	f = 500MHz	20:1			—
C _{iss} Input Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = -5V f = 1MHz			60	pF
C _{oss} Output Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			30	pF
C _{rss} Reverse Transfer Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			2.5	pF
R _{dson} Saturation Resistance	V _{GS} = 20V I _{DS} = 2.5A		1		Ω

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

THERMAL DATA

R _{THj-case}	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 6°C / W
-----------------------	------------------------------------	--------------

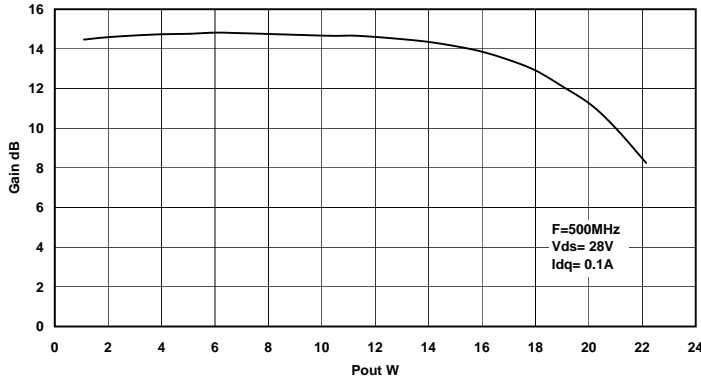


Figure 1
Gain vs. Output Power

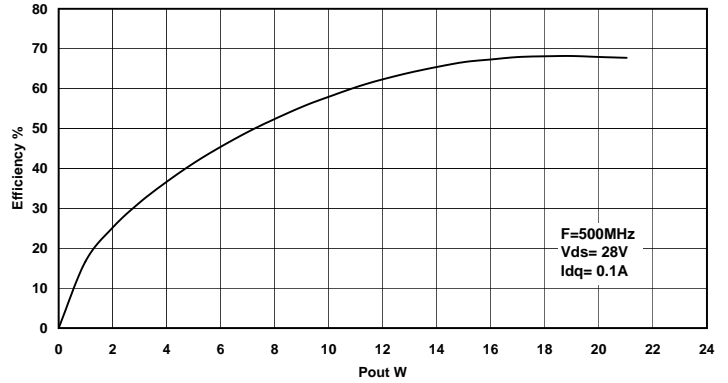


Figure 2
Power added efficiency vs. Output Power.

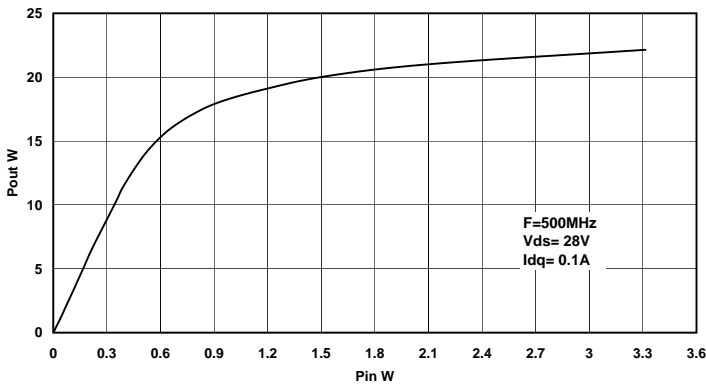


Figure 3
Output Power vs. Input Power.

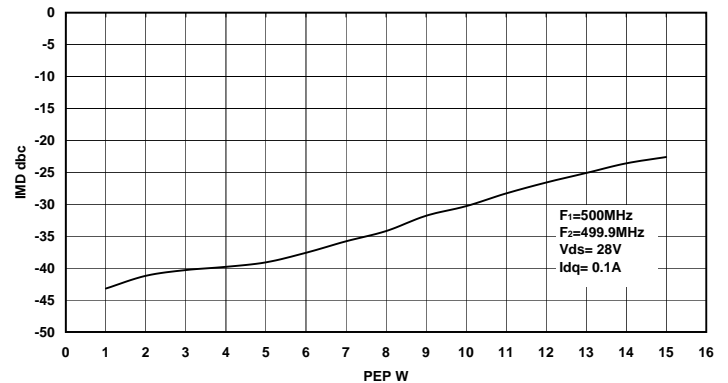


Figure 4
IMD 3 vs. PEP

Typical S Parameters

!D1011UK.s2p
!Vds=28V,Idq=0.1A
MHZ S MA R 50

Freq MHz	S11		S21		S12		S22	
	Mag	Ang	Mag	Ang	Mag	Ang	Mag	Ang
100	0.75	-114.9	12.22	61.1	0.007	108.3	0.81	-139.4
200	0.89	-147.6	3.94	32.2	0.038	111.4	0.92	-158.7
300	0.93	-161.9	2.08	20.9	0.065	102.5	0.95	-166.8
400	0.95	-173.3	1.17	14.0	0.095	94.7	0.97	-173.1
500	0.96	179.4	0.81	11.8	0.120	89.5	0.98	-177.0
600	0.96	172.0	0.57	12.5	0.150	84.2	0.98	179.2
700	0.96	166.5	0.46	15.4	0.176	80.3	0.98	176.5
800	0.96	161.3	0.39	19.7	0.202	76.6	0.97	174.0
900	0.95	155.4	0.35	25.5	0.233	72.3	0.97	171.2
1000	0.95	150.6	0.34	30.0	0.260	68.9	0.96	168.9

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

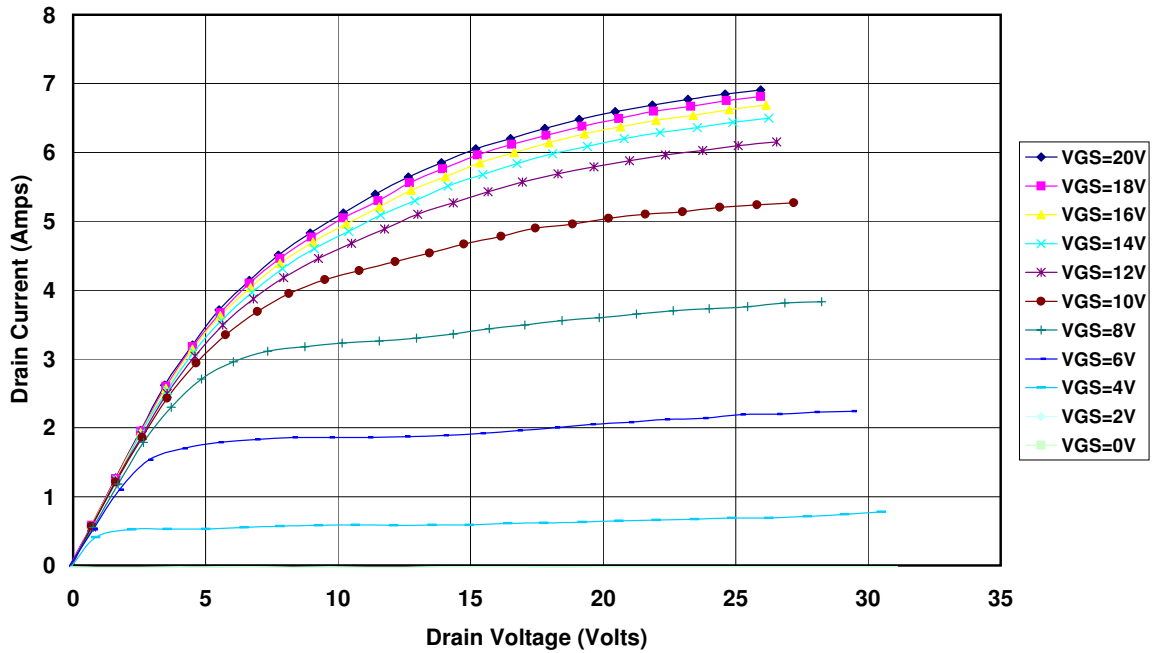


Figure 1 – Typical IV Characteristics.

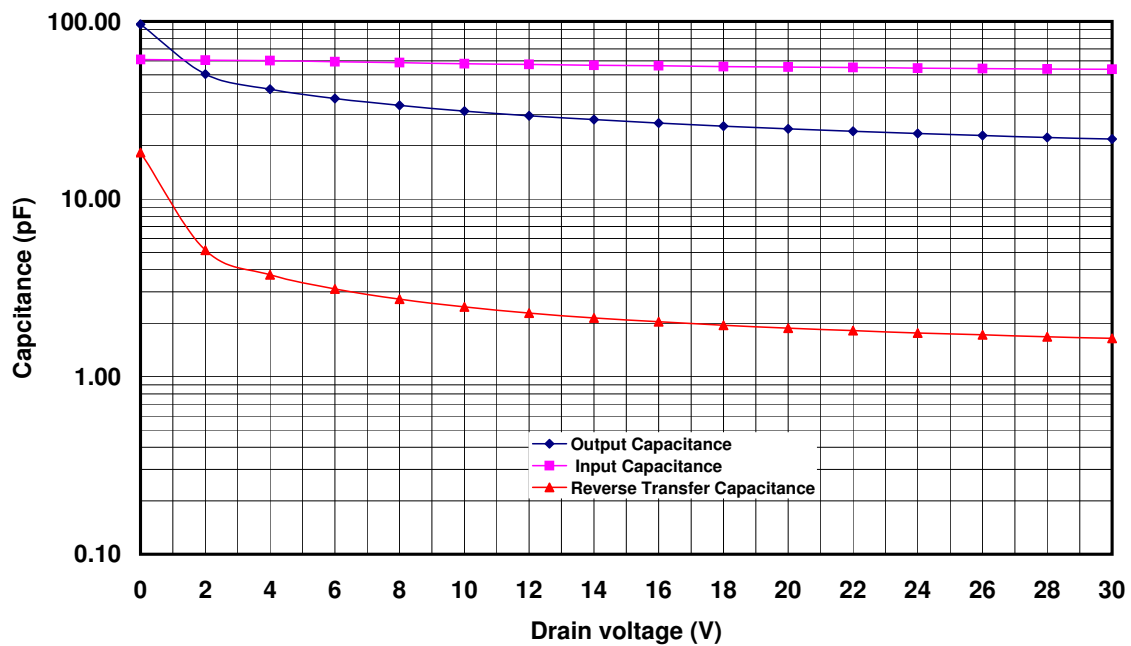
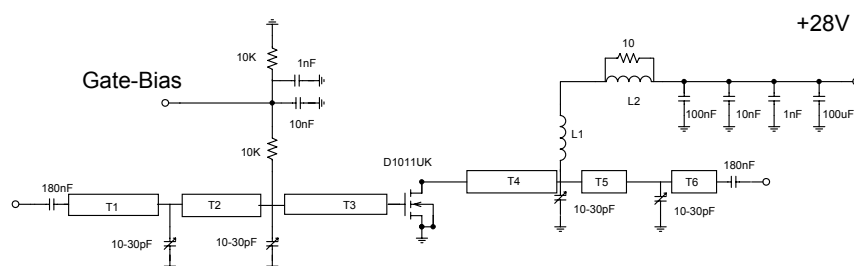


Figure 2 – Typical CV Characteristics.

Semelab Plc reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by Semelab is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However Semelab assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. Semelab encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.



D1011UK 500MHz TEST FIXTURE

Substrate 1.6mm PTFE/glass, Er=2.5

All microstrip lines W=1.5mm

T1 22mm

T2 18mm

T3 18mm

T4 21mm

T5 22mm

T6 13mm

L1 6 turns 24swg enamelled copper wire, 6mm i.d.

L2 1.5 turns 24swg enamelled copper wire on a ferrite



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.